

ТРАНЗИСТОР МАЛОЙ МОЩНОСТИ СВЧ
LOW-POWER MICROWAVE TRANSISTOR

KT3126A

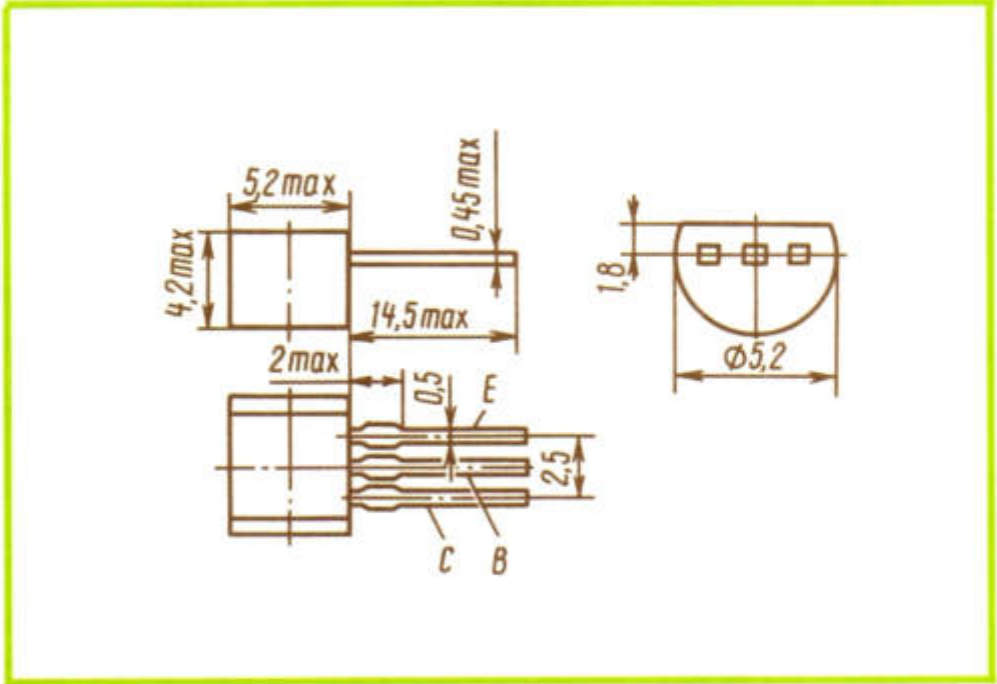
Транзисторы KT3126A предназначены для генерирования, усиления, преобразования колебаний высокой частоты в аппаратуре широкого применения.

Si-p-n-p-EP

The KT3126A transistors are designed for high-frequency oscillation, amplification and conversion in a wide range of applications.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{amb} = -45...+85^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

$U_{CB\ max.}, V$	20
$U_{CE\ max.} (R_{BE} = 10\ k\Omega), V$	20
$U_{EB\ max.}, V$	3
$I_C\ max., mA$	20
$P_C\ max.* (t_{amb} \leq +30^{\circ}C), mW$	150
$t_j\ max., ^{\circ}C$	150



* При $t_{amb} > 30^{\circ}C \Rightarrow P_{C\ max.} = \frac{150 - t_{amb}}{0.8}$

KT3126A

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	KT3126A	Режимы Conditions
1	2	3
$I_{CBO}, \mu A$	≤ 1	$U_{CB} = 15 V$
h_{21E}	≥ 25	$U_{CB} = 5 V$ $I_E = 3 mA$ $f = 50 Hz$
f_T, MHz	≥ 500	$U_{CB} = 10 V$ $I_E = 2 mA$ $f = 10^8 Hz$

1	2	3
C_c, pF	$\leq 2,5$	$U_{CB} = 10 V$ $f = 10^7 Hz$
C_e, pF	$\leq 2,5$	$U_{EB} = 2 V$ $f = 10^7 Hz$
τ_c, ps	≤ 15	$U_{CB} = 5 V$ $I_E = 5 mA$ $f = 10^8 Hz$

